### Kas ehitada Luunja sild?: lisand meie teede- ning liiklemispoliitika plaanikindlustamiseks

Vaher, G. ERK 1934 / lk. 133-138 : joon

### Tuletikumonopol : "ratsionaliseerimise" tulemus ühes meie tööstusharus : [A.S. Eesti Tuletikumonopol]

Vaher, G. Akadeemia 1939 / lk. 131-136

#### Ultra-fast turn-on medium power thyristor

Vaher, G.; **Udal, Andres**; Typpö, J.; Paomets, V.; Sivonen, M. BEC: Baltic Electronics Conference: proceedings of the 4th Biennial Conference, October 9-14, 1994, Tallinn (Estonia). 2 1994 / p. 567-572: ill <a href="https://www.ester.ee/record=b2150914\*est">https://www.ester.ee/record=b2150914\*est</a>

### Ultra-fast-turn-on medium power double thyristor

Vaher, G.; **Udal, Andres**; Sivonen, M.; Paomets, V. ESSDERC'95: proceedings of the 25th European Solid State Device Research Conference, the Netherlands Congress Centre, the Hague, the Netherlands, 25th-27th September 1995 1995 / p. 647-650: ill

### Высоковольтный диод серии В9

Vaher, G.; Vergi, U.; Karuks, O.; Kuusik, E.; Krunks, O.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов: сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 5-12: ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1273235\*est">https://www.ester.ee/record=b1273235\*est</a>

## **Исследование процесса переключения диодных структур низковольтных диодов с эпитаксиальной базовой областью**

Vaher, G.; **Velmre, Enn**; Lumi, J.; **Tarma, Mati**; **Udal, Andres** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 13-17 : ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1356516\*est">https://www.ester.ee/record=b1356516\*est</a>

## Исследование прямой ВАХ мощных диодов с узкой базовой областью

Vaher, G.; **Velmre, Enn**; **Tarma, Mati** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 9-12 : ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1356516\*est">https://www.ester.ee/record=b1356516\*est</a>

## **Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики эпитаксиальных и диффузионных электросварочных диодов**

Vaher, G.; **Velmre, Enn**; Mäe, T.; **Freidin, Boris** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 7-15 : ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1264428\*est">https://www.ester.ee/record=b1264428\*est</a>

# К расчету некоторых параметров процесса лавинного размножения носителей в резких кремниевых р-п-переходах

Vaher, G.; **Velmre, Enn** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 89-96 <a href="https://www.ester.ee/record=b1273235\*est">https://www.ester.ee/record=b1273235\*est</a>

## Низковольтные диоды на большие токи с эпитаксиальной базовой областью

Vaher, G.; Karuks, O.; Mäe, T.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 23-29 : ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1264428\*est">https://www.ester.ee/record=b1264428\*est</a>

### Низковольтный диод для электросварки и гальваники с эпитаксиальной базовой областью

Vaher, G.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 50-62 : ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1273235\*est">https://www.ester.ee/record=b1273235\*est</a>

### О возможности улучшения прямой ВАХ высоковольтного диода

Vaher, G.; Krunks, O.; Kuusik, E.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов: сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 13-20: ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1273235\*est">https://www.ester.ee/record=b1273235\*est</a>

### О целесообразности увеличения обратного напряжения силовых кремниевых диодов

Vaher, G.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 21-24 : ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1273235\*est">https://www.ester.ee/record=b1273235\*est</a>

# Определение характеристик силовых диодных структур методом фотохронографии рекомбинационного излучения

Kruusing, Arvi; **Udal, Andres**; Vaher, G. Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 129-133 <a href="https://www.ester.ee/record=b1264433\*est">https://www.ester.ee/record=b1264433\*est</a>

### Расчет коэффициентов лавинного размножения в резких кремниевых р-п переходах

Vaher, G.; **Velmre, Enn** Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 49 https://www.ester.ee/record=b1313776\*est

**Усовершенствование технологии и конструкции диодов Д143-2000 с применением диффузионной сварки** Vaher, G.; Karuks, O.; Kruus, J.; Surženkov, G.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Технология силовых полупроводниковых приборов : сборник статей 1987 / с. 134-138 : ил., табл <a href="https://www.ester.ee/record=b1353933\*est">https://www.ester.ee/record=b1353933\*est</a>